

Фамилия, имя, отчество	Курочка Александр Сергеевич
Должность, ученая степень, ученое звание	доцент кафедры ТМЭ, к.т.н.
Корпоративная электронная почта	<a href="mailto:kurochka.as@misis.ru">kurochka.as@misis.ru</a>
Рабочий телефон	+7 495 638-44-51
Область научных интересов	Физико-химия взаимодействия энергетических ускоренных частиц (ионов, атомов, электронов) с твердым телом Ионно-плазменные процессы получения тонких пленок Ионно-электронная эмиссия Вторичная электронная эмиссия
Трудовая деятельность	2018, НИТУ МИСИС, доцент кафедры ТМЭ
Образование Дополнительное образование	Московский Институт Стали и Сплавов; направление: электроника и микроэлектроника; специализация: процессы микро- и нанотехнологии
Значимые исследовательские/преподавательские проекты, гранты (тема, заказчик, год, полученные результаты)	Исследование ионной-электронной эмиссии в процессе ИЛТ и РИЛТ, исследование вторичной электронной эмиссии
Значимые публикации (список, не более 10)	1.Features of ion-electronic emission from surface of semiconductors, Journal of nano- and electronic physics, Vol. 5 No 4, 04036(3pp),2013. 2.Features of electronic emission from surface of dielectric thin-film materials with ion-beam etching, Journal of nano- and electronic physics, Vol. 6 No3, 03031(3pp), 2014. 3.Investigation of ion-electronic emission in the process of reactive ion-beam etching of dielectric thin film heterostructures, Russian Microelectronics, Vol. 45, №8, p.1-6, 2016 4. I.A.Rogachev, A.V.Knyazkov, O.I.Meshkov, A.S.Kurochka Features of Formation of Ohmic Contacts and Gate on Epitaxial Heterostructure of AlGa <sub>N</sub> / Ga <sub>N</sub> High Electron Mobility Transistor. // Journal of nano- and electronic physics, Vol. 8 No 2, 02044(3pp) (2016) 5. I.A.Rogachev, O.I.Meshkov, A.S.Kurochka Fabrication of AlGa <sub>N</sub> / Al <sub>N</sub> / Ga <sub>N</sub> HEMT with using non-annealing ohmic contacts // International Conference «International youth Conference on Electronics, Telecommunications and Information Technologies» (YETI-2019), Saint Petersburg, July, 11 2019. 6. V.S. Sedov, A.A.Voronin, M.S. Komlenok, S.S. Savin, A.K. Martyanov, A.F. Popovich, A.S. Altakhov, A.S. Kurochka, D.V. Markus & V.G. Ralchenko. Laser-Assisted Formation of High-Quality Polycrystalline

	<p>Diamond Membranes // Journal of Russian Laser Research, Volume 41, Number 3, 2020, pp 321-326.</p> <p>7. Efimov A.S., Temnov A.M., Korolkova D.D., Zaycev A.A., Dudinov K.V., Rudina A.D., Kurochka A.S., Emelianov A.M., Ranzhin Y.S. Flip-Chip Integration of III-V Chips on Wafer for mmW Applications //2022. 8th All-Russian Microwave Conference (RMC), IEEE 2022 38. pp 220-222.</p>
<p>Индекс Хирша по Scopus Количество статей по Scopus</p>	<p>3 10</p>
<p>Значимые патенты</p>	<p>1. Способ изготовления омических контактов мощных электронных приборов. Патент на изобретение 2756579 С1. Дата публикации: 01.10.2021. Заявка № 2020141595 от 16.12.2020.</p> <p>2. Мощный полевой транзистор СВЧ на полупроводниковой гетероструктуре на основе нитрида галлия. Номер патента: RU 2782307 С1. Дата публикации: 25.10.2022 Номер заявки: 2021139166 от 28.12.2021.</p> <p>3. Способ изготовления мощного полевого транзистора СВЧ на полупроводниковой гетероструктуре на основе нитрида галлия. Патент на изобретение RU 2787550 С1. Дата публикации: 10.01.2023. Заявка № 2022110907 от 21.04.2022.</p> <p>4. Способ изготовления тонкопленочного конденсатора электронной техники. Патент на изобретение RU 2799811 С1. Дата публикации: 12.07.2023. Заявка № 2022135340 от 30.12.2022.</p> <p>5. Способ изготовления полевого транзистора СВЧ. Патент на изобретение RU 2806808 С1, 07.11.2023. Заявка от 09.03.2023.</p>
<p>Научное руководство/ Преподавание</p>	<p>Научный руководитель выпускными квалификационными работами, магистерскими диссертациями, кандидатскими диссертациями Преподаватель, лекции, практические занятия, лабораторные работы по следующим дисциплинам: «Элионная технология в микро- и наноиндустрии», «Высоковакуумное оборудование», «Технология тонких пленок полупроводников и диэлектриков», «Молекулярно-пучковая и МОС-гидридная эпитаксия»</p>